PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-006808

(43) Date of publication of application: 14.01.1991

(51)Int.CI.

H01G 9/02 H01G 9/04 H01G 9/24

(21)Application number: 01-142718

(71)Applicant: SHOWA DENKO KK

(22)Date of filing:

05.06.1989

(72)Inventor: NAITO KAZUMI

NAKAMURA HIDENORI

(54) MANUFACTURE OF SOLID ELECTROLYTIC CAPACITOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To shorten electrolytic polymerization time and to desirably reduce loss coefficient by processing valve operation metal having a dielectric oxide film layer on a surface with oxidizer, and then forming a semiconductor layer on the film layer by electrolytic polymerization in electrolyte containing specific monomer.

CONSTITUTION: After valve operation metal having a dielectric oxide film layer on a surface is processed with oxidizer, and a semiconductor layer of solid electrolyte is formed on the film by electrolytic polymerization in electrolyte containing monomer represented by a formula (I). In the formula (I), R1, R2 are alkyl group, alkoxy group or H, X is O, S or NR3, and R3 is alkyl group or H. When the metal is dipped in the electrolyte to be electrolytically polymerized, electrolytic polymerization and simultaneously chemical polymerization occur. As a result, the electrolytic polymerization time is shortened. Further, the

polymerization occurs when the chemically polymerized part is very small, and a boundary resistance between the chemical polymerization layer and the electrolytic polymerization layer becomes vary small, and the DF value of a capacitor can be maintained desirably low.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

@公開 平成3年(1991)1月14日

◎ 公開特許公報(A) 平3-6808

⑤Int. Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 H 01 G 9/02 3 3 1 7924-5E 9/04 3 0 1 7924-5E 9/24 C 7924-5E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

公発明の名称 固体電解コンデンサの製造方法

②特 願 平1-142718

20出 願 平1(1989)6月5日

⑫発 明 者 内 藤 一 美 東京都大田区多摩川 2 -24-25 昭和電工株式会社総合技

術研究所內

@発明者中村英則東京都大田区多摩川2-24-25昭和電工株式会社総合技

術研究所内

②出 願 人 昭和電工株式会社 東京都港区芝大門1丁目13番9号

100代 理 人 弁理士 寺 田 實

明細書

1. 発明の名称

固体電解コンデンサの製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 表面に誤電体験化皮膜層を有する弁作用金属 を酸化剤で処理した後、一般式 (I)

(A'、 R"はアルキル基、アルコキシル基又は H 、 Xは O、 S又は NR"、R"はアルキル基又 は H

で表わされるモノマーを含む電解液中で電解重合によって前記誘電体酸化皮膜層上に半導体層を形成することを特徴とする固体電解コンデンサの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、高周波性能の良好な固体電解コンデンサの製造方法に関する。

[従来の技術]

固体電解コンデンサは表面に誘電体酸化皮膜を 有するアルミニウム、タンタル、ニオブ等の弁作 用金属に固体電解質である半導体を付着した構造 を有している。

世来、この種の固体電解コンデンサの固体電解では、主に硝酸マンガンの熱分解により形成される二酸化マンガンが用いられている。しかし、この熱分解の際に必要な高熱と発生する NO・ガスの酸化作用等によって誘電体であるアルミニウム、タンタルなどの誘電体酸化皮膜の損傷が起り、そのため耐電圧は低下し、調れ電流が大きくなり、誘電特性を劣化させる等大きな欠点がある。また再化成という工程も数回必要になる。

これらの欠点を補うために高熱を付加せずに固体電解質を形成する方法、つまり高電導性の高分子半進体材料を固体電解質とする方法が試みられ

ている。その例としては、下記の一般式(I)で表わされるモノマーを重合して得られる高分子化合物にドーパントをドーブして得られる電源性高分子化合物を固体電解質とする固体電解コンデンサが知られている。

R'、R"はアルキル基、アルコキシル基又は H、 Xは O、 S又は NR"、R"はアルキル基又 は H

又、この種の電導性高分子化合物を固体電解質とする固体電解コンデンサの製造方法として、上記一般式 (I) で表わされるモノマーを溶解した溶液中で電解重合することによって作製する方法も知られている。

[免明が解決しようとする課題]

されたもので表面に誘電体酸化皮膜層を育する弁 作用金属を酸化剤で処理した後、一般式(〔)

R¹、R²はアルキル基、アルコキシル基又は H 、 Xは O、 S又は NA²、R²はアルキル基又 は H

で表わされるモノマーを含む電解液中で電解重合によって誘電体酸化皮膜層上に固体電解質である。 ・る半導体層を形成する固体電解コンデンサの製造 方法にある。

以下、本発明について詳細に説明する。

本発明に於いて固体電解コンデンサの隔極として用いられる弁作用金属としては、例えばアルミニウム、タンタル、ニオブ、チタン及びこれらを 基質とする合金等、弁作用を有する金属がいずれ

ところが前者の手法では、外部電極の配置個の に限りがあるため充分な重合時間を短縮する目的 には使用できず、又、後者の手法では、先に化学 重合して形成した電源性高分子化合物層が存在す るため、後に電解重合した圏との界面抵抗により 作製した固体電解コンデンサの損失係数で DFと称する)が大きくなるという問題点があった。

[護題を解決するための手段]

本発明は、上述した問題点を解決するためにな

も使用できる。

弁作用金属の表面に設ける誘電体酸化皮膜は、 弁作用金属の表面部分に設けられた弁作用金属目 体の酸化物層であってもよく、或いは、弁作用金 属の表面上に設けられた他の誘電体酸化物の層で あってもよいが、特に弁作用金属自体の酸化物か らなる層であることが好ましい。いずれの場合に も酸化物層を設ける方法としては、電解液を用い た関極化成法など従来公知の方法を用いることが できる。

次に、本発明で用いられる酸化剤としては、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム等の過硫酸塩、 FeCl s、 A1Cl s、 SnCl s 、塩素酸塩、過塩素酸塩、次亜塩素酸塩、過センガ 過硫酸塩が公害等の問題も無く、水に可治で あり、工業的に利用しやすいため好都合、利に可あり、工業的に利用しやする方法は、例えば酸化剤を含有する溶液に弁作用金属を浸液し、引き上げて乾燥する方法が挙げられる。或いは酸化剂を

含有する溶液を弁作用金属に噴<mark>繋して</mark>処理しても よく、一般に酸化剤を弁作用金属に均一に付着さ せればよい。

次に、本発明で用いられるモノマーは、前記の 一般式 (1) の構造を有するものである。

て使用してもよい。

本発明に用いる固体電解質は電導度が10°~10°S・c= 'オーダーのものが得られ、電導度が高い程、作製した固体電解コンデンサの高周波でのDFが低く良好なものとなる。

本発明の方法による固体電解コンデンサは、上述した固体電解質層の上にカーボンベースト又は
/ 及び銀ペースト等で陰極層を取り出し、更に樹脂やケース等、従来公知の方法で封口して製品と
される。

[作用]

酸化剤で処理した弁作用金属を電解液中に浸漬して電解重合すると、電解重合と同時に化学重合も生じ、その結果、電解重合時間が短時間となる。しかも、化学重合した部分部分が各々微小な時に電解重合が起り、化学重合層と電解重合層との界面抵抗もわずかなものとなる。従って作製した固体電解コンデンサのDF値は低く良好なものとなる。

合層との界面抵抗もわずかなものとなる。

本発明に使用する電解液は従来公知の電解液を使用することができる。例えば、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネート、ァーブチロラクトン、アセトニトリル、ジメチルホルムアミド、スルフォラン、メチルスルホキシド、ニトロメタン、水等の溶媒に I - 、C1- 、F- 、Br- 、C10*-、BP*-、AsF*-、PF*-、F*CSO*-、BC1*-、NO*-、POF*-、CN-、SiF*-、CH*COO-、C**-、BC0-、C**-、BC1*-、BC*-、BC*-、C**-、SO*-、SiF*-、BF*-等のアルカリ金属塩もしくはハロゲンイオンを除いてアンモニウム塩からなる電解質を溶解したものである。

又、前述した電導性高分子化合物にさらにドーパントとして I **、 Br **、 SO **、 As F **、 Sb F **、 トルエンスルフォン酸、ペンゼンスルフォン酸等の電子受容体を化学的方法を用いてドープするか、或いは、 BF ** **、 C10 ** **、 PF ** **、 As F ** **、 トルエンスルフォン酸イオン、ペンゼンスルフォン酸イオン、 タのアニオンを電気化学的方法を用いてドーブし

以下、実施例及び比較例を示して説明する。 実統例1~6

りん酸とりん酸アンモニウム水溶液中で化成処 理して表面に誘電体酸化皮膜層を形成したl0μF / cmfのアルミニウムエッチング箱(以下化成箔 と称する) の小片 0.5cm×0.5 cmを 120枚用意 し、各実施例にそれぞれ20枚ずつ使用した。表1 に記載したそれぞれの酸化剤溶液中に化成箔を浸 漬し引き上げた。更に、表1に記載されたモノ マーを 0.2モル溶解させた0.05NBv.NBF4アセトニ トリル溶液中に前述した酸化剤処理液の化成箔を 浸漬し電解重合を行った。約1時間後、化成箔上 に形成された電導性高分子化合物を水で充分洗浄 した後、乾燥した。形成された固体電解質の電導 **应は、おおよそ10~200 S・cm⁻¹であった。次に** 固体電解質層を形成した化成箔に銀ベーストで陰 極層を形成した後、樹脂封口して固体電解コンデ ンサを作製した。

(以下余白)

〔実施例〕

表し

_		
	モノマー	酸化剤
実施例1	ピロール	過硫酸アンモニウム 20%水溶液
" 2	N-メチル ピロール	逸窟酸アンモニウム 20%水溜液
<i>"</i> 3	3-メチル チオフェン	過硫酸アンモニウム 20%水溶液
<i>"</i> 4	フラン	塩化鉄 10%7ルコール 溶液
<i>"</i> 5	チオフェン	塩化鉄 10% アルコール 溶液
<i>"</i> 6	ヒロール	過硫酸カリ 5%水溶液

せずに実施例1の電解液中で3時間、電解重合を行った場合、比較例2は、実施例1の酸化剤処理を行い、更に続けて窒温でピロールモノマー蒸気にあてて化学重合を行った後、実施例1の電解液中で1時間、電解重合を行った場合であり、この2通りの方法で半導体層を形成した。引き続き実施例と同様にして陰極層を形成し樹脂封口して固体電解コンデンサを作製した。

以上作製した園体電解コンデンサの性能を表 2 に示した。

(以下余白)

比較例1~2

実施例と同様の化成箔を40枚用意し、各比較例に20枚づつ使用した。比較例1は、酸化剤処理を

表 2

	容量· μF	DF.	DF
実施例 1	2.2	0.8	3.8
" 2	· 2.0	0.8	4.1
<i>"</i> 3	ι. 9	0.9	5.8
<i>"</i> 4	1.9	0.9	5.9
<i>"</i> 5	1.9	1.0	6.1
<i>"</i> 6	2.1	0.8	4.3
比較例1	1.4	1.5	8.8
<i>"</i> 2	2.1	1.2	15.4

- 120Hzでの値
- ** 10kHzでの値

〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明の固体電解コンデンサの製造方法によれば、電解取合によって半導体暦を形成する前に、酸化剤処理を行うので、電解重合時間が短くですみ、かつDF値の良好な固

体電解コンデンサを作製することができる。

特許出願人 昭和電工株式会社 代 理 人 弁理士 寺田 實

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.